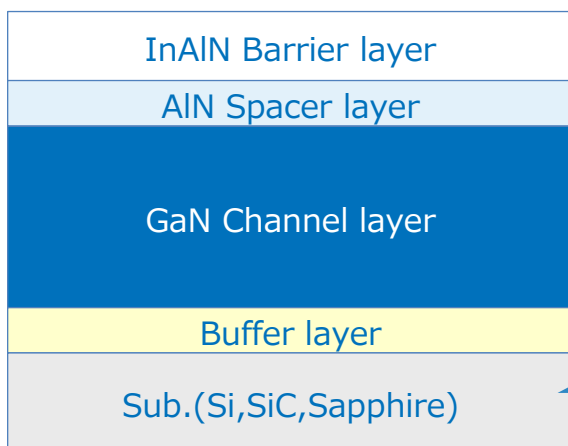
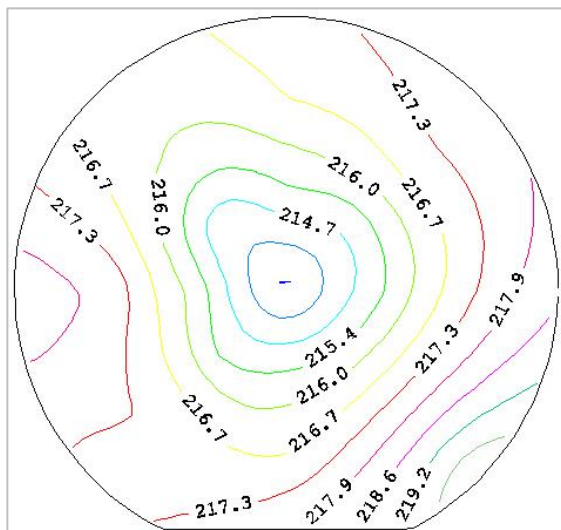


窒化物半導体エピタキシャルウエハ InAlN / GaN HEMT

InAlN/GaN-HEMTは次世代の高速・高出力デバイスとして期待されています。
NTT-ATなら小口径の研究開発エピタキシャルウエハから大口径Si基板上エピタキシャルウエハまで提供いたします。



Si: 8 inchまで
SiC: 4 inchまで
Sapphire: 3 inchまで



←6インチ Si基板上エピタキシャルウエハ
シート抵抗分布

ホール効果測定値↓

Ave.: 216 ohm/sq. (Var.: 3.6%)

項目	測定値
Rs [ohm/sq.]	219
μ [cm ² /Vs]	1300
Ns[cm ⁻²]	2.20e13

*本カタログ記載の数値等は測定例での値であり、本製品の保証値ではありません。

*本カタログ記載の内容は予告なく変更することがあります。カタログ記載内容 2023年05月現在。

お問い合わせ先 https://keytech.ntt-at.co.jp/epi/prd_1002.html

